

60Vシリーズ パワー-MOSFET

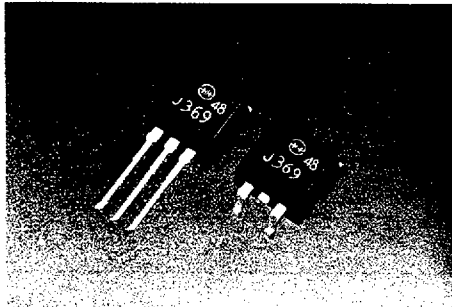
60V SERIES POWER MOSFET

高速スイッチング
P-チャンネル、エンハンスメント型

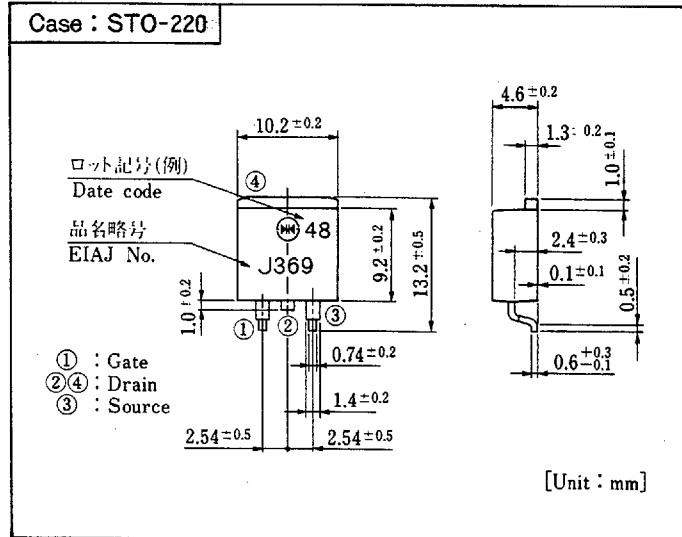
2SJ369

(F10S6P)

-60V -10A



外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



■ 定格表 RATINGS

■ 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55~150	°C
チャンネル温度 Channel Temperature	Tch		150	°C
ドレイン・ソース電圧 Drain-Source Voltage	V _{DSS}		-60	V
ゲート・ソース電圧 Gate-Source Voltage	V _{GSS}		±20	V
ドレイン電流 Continuous Drain Current	DC	I _D	-10	A
	Peak	I _{DP}	パルス幅 ≤ 10μs, duty ≤ 1/100 Pulse width ≤ 10μs, Duty cycle ≤ 1/100	A
ソース電流(直流) Continuous Source Current (DC)	I _S		-10	A
全損失 Total Power Dissipation	P _T	T _c = 25°C	50	W
アバランシェ電流 Avalanche Current	I _{DA}	T _c = 25°C	-10	A

■ 電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (T_c = 25°C)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			min.	typ.	max.	
ドレイン・ソース降伏電圧 Drain-Source Breakdown Voltage	V(BR) _{DSS}	I _D = -1mA, V _{GS} = 0V	-60			V
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{DS} = -60V, V _{GS} = 0V			-100	μA
ゲート漏れ電流 Gate-Source Leakage Current	I _{GSS}	V _{GS} = ±20V, V _{DS} = 0V			±10	μA
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	g _{fs}	I _D = -5A, V _{DS} = -10V	3.9	5.6		S
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	R _{DS(ON)}	I _D = -5A, V _{GS} = -10V		0.10	0.16	Ω
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V _{TH}	I _D = -1mA, V _{DS} = -10V	-1.0	-1.5	-2.0	V
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source-Drain Diode Forward Voltage	V _{SD}	I _S = -5A, V _{GS} = 0V			-1.5	V
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case			2.50	°C/W
ゲートチャージ特性 Gate Charge Characteristics	Q _g	V _{GS} = -10V, I _D = -10A, V _{DD} = -48V		-37		nC
入力容量 Input Capacitance	C _{iss}	V _{DS} = -10V, V _{GS} = 0V, f = 1MHz		900		pF
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}				210	
出力容量 Output Capacitance	C _{oss}				460	
ターンオン時間 Turn-on Time	t _{on}	I _D = -5A, V _{GS} = -10V, R _L = 6Ω		75	150	ns
ターンオフ時間 Turn-off Time	t _{off}			300	600	

8219387 0002221 T94

■ 特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

